

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第6部門第2区分

【発行日】平成17年4月7日(2005.4.7)

【公開番号】特開2003-140345(P2003-140345A)

【公開日】平成15年5月14日(2003.5.14)

【出願番号】特願2001-338103(P2001-338103)

【国際特許分類第7版】

G 03 F 7/039

G 03 F 7/004

H 01 L 21/027

【F I】

G 03 F 7/039 601

G 03 F 7/004 501

H 01 L 21/30 502 R

【手続補正書】

【提出日】平成16年5月25日(2004.5.25)

【手続補正1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】特許請求の範囲

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

(A) ポリマー骨格の主鎖及び/又は側鎖にフッ素原子が置換した構造を有し、且つ酸の作用により分解し、アルカリ現像液に対する溶解度を増大する基を有するフッ素基含有樹脂、

(B) 活性光線又は放射線の照射により、酸を発生する化合物、及び

(D) 少なくとも一つのフッ素原子を有する化合物を含有することを特徴とするポジ型レジスト組成物。

【請求項2】

(A)の樹脂が、パーフルオロアルキレン基、パーフルオロアリーレン基から選択される部位を、ポリマー骨格の主鎖に少なくとも一つ有するか、パーフルオロアルキル基、パーフルオロアリール基、ヘキサフルオロ-2-プロパノ-ル基、及びヘキサフルオロ-2-プロパノ-ル基のOH基を保護した基から選択される部位を、ポリマー骨格の側鎖に少なくとも一つ有するフッ素基含有樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項3】

180nm以下の波長の遠紫外光による露光用組成物であることを特徴とする請求項1又は2に記載のポジ型レジスト組成物。

【請求項4】

請求項1～3のいずれかに記載のポジ型レジスト組成物によりレジスト膜を形成し、当該レジスト膜を露光、現像することを特徴とするパターン形成方法。